" Исследование влияния обтекателя на уровень дальнего бокового излучения антенной системы", (совместно с Важинским С.Э) Сборник трудов ХВУ, Вып 21, 1999 г.

УДК 821.398.87 Доктор физико-математических наук Сухаревский И.В. Важинский С.Э.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБТЕКАТЕЛЯ НА УРОВЕНЬ ДАЛЬНЕГО БОКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ

Исследованы с помощью асимптотической методики вклады в боковое излучение антенной системы, порожденные отражениями от внутренней поверхности обтекателя.

Установлено существование в системе переотраженных лучей каустик (огибающих) и точек стационарной фазы, соответствующих заданным направлениям в боковых лепестках диаграммы излучения антенны.

Оценены относительные вклады, обусловленные наличием точки стационарной фазы. Приведены результаты численных расчетов и практические рекомендации по снижению уровня бокового излучения.

1. Теоретические основы проведенных исследований.

В ходе исследований за основу было принято интегральное представление комплексной диаграммы направленности антенной системы (AC) с апертурной антенной и диэлектрическим обтекателем [1], которое в частном случае двумерной задачи при Е- поляризации, имеет вид:

$$U(\vec{R}^{0}) = \int_{-1}^{1} U\left(x_{1} \middle| \vec{R}^{0}\right) \cdot e^{jk_{0}} \left[\Phi_{0}(x_{1},h) + (\vec{p}\cdot\vec{x}) \right] \cdot dx_{1}, \tag{1}$$

где $U\left(x_{1} \middle| \vec{R}^{0} \right) = -\left(\cos\psi + \frac{\partial\Phi_{0}}{\partial x_{3}}\right) \cdot \Lambda_{1}A\sqrt{\frac{\varepsilon_{0}}{\mu_{0}}}, \quad U(\vec{R}^{0}) = \vec{e}_{2} \cdot \vec{E}\left(\vec{R}^{0}\right),$

А- амплитуда поля приходящего из дальней зоны, Λ_1 –амплитуда стороннего поля в апертуре.

Интеграл (1) допускает оценку методом стационарной фазы, изложенным в работе [3]. Используя в расчетах асимптотический, двухпараметрический метод расчета прохождения электромагнитной волны через слоистую структуру можно найти значения амплитуды поля в точках на поверхности обтекателя и в апертуре. Этот метод подробно описан в работе [2]. В реальной системе, как показали исследования, переотраженные от внутренней поверхности обтекателя S лучи образуют «огибающую» (каустику) семейства отраженных лучей, описываемую уравнением: $t = \frac{\cos \alpha(s)}{2\kappa(s)}$, где t- расстояние от точки отражения до точки касания от-

раженного луча к каустике, к=к(s) – кривизна S в точке отражения, s- дуговая координата на S, α - угол прихода луча относительно нормали к точке отражения. Пройдя касание к каустике, поле отраженной от S волны скачком меняет фазу на

 $\pi/2$. Например, при $g(\xi) = \frac{\xi^2}{2}$, угле падения луча $\vartheta = \frac{\pi}{2}$ имеем параметрическое уравнением каустики $x = \frac{\xi}{2} (3 - \xi^2); z = \frac{3}{2} \xi^2$ (см. Рис.1).



При рассмотрении переотраженного поля используется формульная зависимость, позволяющая определить связь координат точек отражения (ξ , ζ) на поверхности S и соответствующих им точкам на апертуре (x, h);

$$x = \xi + (h - g(\xi)) \frac{l_x^o}{l_z^o},$$
(2)

где l_x^0, l_z^0 -координаты орта отраженного луча, ξ - координата точки отражения по оси 0Z, h – расстояние до апертуры по оси 0Z, ζ – координата точки отражения по оси 0X.

2.Методика нахождения вклада точки стационарной фазы в боковое излучение антенной системы с обтекателем.

Методика расчетов ниже изложена, в основном, на двумерной модели антенной системы с оживальным обтекателем 9М38. Результаты расчетов же приведены для изделий 9М38 и С200.

1. Все расчеты проведены в безразмерной постановке. В частности, при этом безразмерное уравнение внутренней стенки S обтекателя изделия 9M38 принимает

вид $\zeta = g(\xi)$, где $g(\xi) = \frac{\xi^2}{2}$, вместо уравнения S в размерных величинах $z = 20 \cdot x^2$ (z, x – в сантиметрах, 20 – размерный коэффициент размерностью 1/см).

2. Вся апертура разбивается на n - интервалов Δ1, Δ2,..Δn и определяются координаты точек (x_i, h), являющиеся границами этих интервалов.

По имеющимся координатам точек x_i на апертуре вычисляются соответствующие им точки ξ_i на внутренней стенке обтекателя путем решения уравнения (2) относительно переменной ξ .



Рис.2

При этом оказывается, как показано на рис.2, что точке х на апертуре соответствуют две точки ξ на поверхности обтекателя находящиеся левее и правее точки стационарной фазы. Таким образом получаем участок на внутренней поверхности обтекателя, все отражаемые лучи от которого попадают на апертуру AC. В развернутом виде используемое здесь уравнение связи имеет вид:

$$x = \xi + (h - g(\xi)) \cdot \frac{g(\xi)^2 - 1 + 2 \cdot g(\xi) \cdot ctg\theta}{(g(\xi)^2 - 1) \cdot ctg\theta - 2 \cdot g(\xi)}.$$
(3)

По формулам $\xi_0 = -ctg \frac{\vartheta - \psi}{2}$ и $\zeta_0 = g(\xi_0)$ [4] определяются координаты точки стационарной фазы на поверхности S, а из (3) соответствующая ей координата х на апертуре.

3. Для построения фазовой функции Φ(x, ξ) переотраженного поля в апертуре используется математическая модель, в основе которой лежит электрическое сканирование, характеризуемое углом сканирования у и, таким образом выводит-

ся выражение: $\Phi(\mathbf{x},\xi) = -\mathbf{x} \cdot \sin \psi - \mathbf{h} \cdot \cos \psi + \sqrt{(\mathbf{x}-\xi)^2 + (\mathbf{h}-g)^2} - \vec{R}^{o} \cdot \vec{\xi}$

- С использованием лучевых представлений падающей и переотраженной волн, основанных на двухпараметрической асимптотической методике [2], расчитывается прохождение падающей волны через обтекатель и отражение от поверхности S. Определяются координаты (x1, z1) точек входа лучей в поверхность обтекателя (согласно []), соответствующих точкам отражения x1 = -ξ 2ctg θ, находятся В_i- значения амплитуды поля в точке отражения.
- 5. Величина переотраженного поля в апертуре определяется по асимптотической

формуле
$$U = e^{j \cdot k \cdot \Phi} \cdot B \cdot \sqrt{\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - 2 \cdot \kappa \cdot T}},$$

где кривизна поверхности в точке отражения $\kappa = \frac{|\mathbf{g}^{\gamma}|}{(1 + \mathbf{g}^{\gamma 2})^{\frac{3}{2}}},$

 $T = \sqrt{(x - \xi)^2 + (h - g)^2}$ -расстояние от точки отражения вдоль отраженного луча апертуры.

Определяется, происходит ли касание отраженного луча к каустике. Условие касания T>T_к (при выполнении этого неравенства фазовая функция увеличива-

ется на $\pi/2$), где $T_K = \left| \frac{\cos \alpha}{2 \cdot \kappa} \right|$ - расстояние, пройденное отраженным лучом до

каустики.

6. Вторая производная фазовой функции в точке стационарной фазы, как показано в [3], определяется выражением: $\frac{d^2 \Phi}{dx^2} = -2 \cdot g^{"} \cdot \sin^2 \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{dx}{d\xi}\right)_{st}}$, а вклад ее

окрестности в интеграл
$$I_{st} = e^{j \cdot k \cdot \Phi} \sqrt{\frac{2 \cdot \pi}{k \cdot |\Phi^{\uparrow}|}} \cdot U_{st} \cdot \chi$$
, где $\chi = e^{-\frac{\pi \cdot j}{2}}$

 Вычисление поля, излучаемого апертурой, производится в работе по специальной квадратурной формуле, основанной на кусочно-линейных аппроксимациях амплитудной и фазовой функций на каждом из частичных интервалов Δ1,Δ2,..Δn (не содержащих точки стационарной фазы) и имеющей вид:

$$I_{i} = \delta \cdot e^{jk\Phi_{i-1}} \left(\frac{e^{j \cdot k \cdot \delta \Phi_{i}} - 1}{j \cdot k \cdot \delta \Phi_{i}} u_{i-1} - \delta u_{i} \frac{e^{j \cdot k \cdot \delta \Phi_{i}} - 1 - j \cdot k \cdot \delta \Phi_{i}}{(j \cdot k \cdot \delta \Phi_{i})^{2}} \right) \cdot \chi_{i},$$

где u_i - амплитуда поля в точке на апертуре $\delta u_i = u_{i+1} - u_i, \delta \Phi_i = \Phi_{i+1} - \Phi_i.$

8. Вычисляется суммарная величина переотраженного поля на интервалах левее и правее области точки стационарной фазы, результаты суммируются.

$$I_{CYMMAPHAR} = \sum_{i=1}^{n+1} I_i \, .$$

9. На последнем этапе вычисляется относительный вклад точки стационарной фазы в переотраженное поле $\frac{Vkl}{1+\frac{|I_{суммарная}|}{|I_{st}|}}.$

3.Анализ влияния отражений от стенки обтекателя на помехозащищенность.

1. Расчетами на идеализированной модели близкой к системе 9м38 было показано, что по крайней мере в диапазоне углов 60-85⁰ (как при электрической, так и при механической системе сканирования) переотраженное от внутренней стенки обтекателя поле может составить заметный вклад в боковое излучение антенной системы. На графике (рис.3),



где θ - угол прихода луча из дальней зоны, V- отношение величин переотраженного и прямого полей, показана зависимость величины относительного вклада переотраженного поля в суммарное поле на апертуре при различных углах прихода волны. В первом случае (левый график), угол сканирования $\psi = 5^{0}$, при $\theta = 65-73^{0}$ переотраженное поле на апертуре составляет более 50% от величины суммарного поля волны приходящей с бокового направления. При увеличении угла сканиро-

вания (правый график) $\psi = 10^{\circ}$, происходит увеличение вклада переотраженного поля в диапазоне углов $\theta = 68-75^{\circ}$.и при $\theta > 85^{\circ}$.

2.Существенная роль точек стационарной фазы в поле переотраженных лучей и на апертуре антенны видна из проведенных компьютерных исследований оживального обтекателя изделия 9М38. По результатам вычислений построены графики (рис.4) оценки относительных вкладов окрестности точки стационарной фазы в уровень переотраженного поля. Из графиков видно, что при $\psi=0$ в диапазоне углов $\theta=70-85^{\circ}$ относительный вклад точки стационарной фазы в переотраженное поле составляет 58-70%, а при $\psi=5^{\circ}$ -52-70%.



Рис.4

Количественные значения относительных вкладов при различных углах сканирования ψ указаны в таблице 1.

Таблица 1

ВКЛАД (V)	УГОЛ Э						
при	70	75	80	85	90		
$\psi = 0$	70	63	66	58	58		
$\psi = 5$	70	64	65	55	53		
$\psi = 10$	-	64	66	53	47		

Относительные вклады точек стационарной фазы в отраженное поле при варьировании углов θ и ψ , полученные при расчетах по методике приведенной в п. 2 для антенной системы изделия С-200 приведены в таблице2 и на рис.5. Из графиков видно, что при угле $\psi = 5^0$ в диапазоне углов $\theta = 70-85^0$ вклады «стационарной области» составляют от 52 до 75%. С увеличением углов сканирования ψ значения вкладов точки стационарной фазы составляют 56-70%

3. Из вышесказанного следует, что:

1. существует принципиальная возможность значительного снижения влияния переотражений путем локальных компенсаций малых окрестностей точек стационарной фазы.







Таблица 2

ВКЛАД (V)	УГОЛ Э						
при	70	75	80	85	90		
$\psi = 5$	53	62	73	74	-		
$\psi = 10$	64	61	64	60	-		
$\psi = 20$	65	73	68	56	-		

- 2. наличие каустик, и точек стационарной фазы, точное определение их местоположения, делает возможным, компенсацию переотражений путем установки поглащающих элементов в рассчитываемых малых областях апертуры или на обтекателе AC.
- 3. для антенных систем с фазированной антенной решеткой возможна компенсация переотражений путем составления специальных алгоритмов управления излучением, при котором в апертуре будут «отключаться» при обработке области точки стационарной фазы.
- 4. в АС с обтекателем имеется область в которую не попадуют переотраженные лучи.

Литература.

[1] Сухаревский И.В. Сухаревский О.И., Расчет поля, возбуждаемого излучающей апертурой в присутствии произвольной системы рассеивателей. Радиотехника и электроника, 1986, Вып.1, с.8-13.

[2] Сухаревский И. В. Асимптотические методы решения некоторых классов задач дифракции волн. «Радиотехника» (Всеукраинский межведомственный научнотехнический сборник), вып.100, 1996. С.19-41.

[3] Сухаревский О.И., Метод стационарной фазы. Дополнительные разделы высшей математики. Асимптотические формулы и разложения.1996, Вып.1, с.24-29.
[4] I.V. Sukharevsky, S. E. Vashinsky, About the stationary phase points and caustic influence on lateral radiation of antenna systems with radomes. MMET-98, с.537 –539.